



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

SS8550 (PNP)

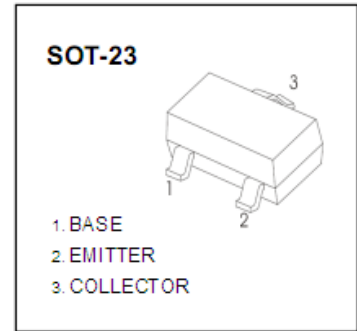
印章/Marking : Y2

特点/Features :

I_c 电流大 ;

用途/Applications :

用于功率放大电路 , 与 SS8050 互补。



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	-40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	-25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_c	-1.25~-1.5*	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_c	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

注 : I_b 在 100mA 时 , I_c 可在 1.5A 连续工作 , I_b 减小时 , I_c 最大连续工作电流会减小。

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_c = -100 \mu A, I_E = 0$	-40		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_c = -100 \mu A, I_B = 0$	-25		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E = -100 \mu A, I_C = 0$	-5		V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB} = -40V, I_E = 0$		-0.1	μA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$		-0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CE0}	$V_{CE} = -20V, I_B = 0$		-0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -1V, I_c = -100mA$	120	400	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_c = -800mA$	40		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_c = -800mA, I_B = -80mA$		-0.5	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_c = -800mA, I_B = -80mA$		-1.2	V
基极-发射极导通压降	$V_{BE(ON)}$	$I_c = -10mA, V_{CE} = -1V$		-1	V
基极-发射极正向压降	V_{BEF}	$I_B = -1A$		-1.55	
特征频率	f_T	$V_{CE} = -10V, I_c = -50mA, f = 30MHz$	100		MHz
输出电容	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$		20	pF

h_{FE} 分档/Classification of $h_{FE(1)}$

档位/Rank	L	H	J
范围/Range	120~200	200~350	300~400



典型特性曲线图/Typical Characteristics

